

测试条件: (Measuring Conditions:)

- 1、亮电阻，
用400~600Lux光照射2小时后，在标准A光源(色温2854K)下用10Lux和100Lux光测量。
- 2、暗电阻，
关闭10Lux光照后第10秒的电阻值。
- 3、 γ 值，
表示电阻的变化与入射光线变化之间的关系，可由下式计算:

$$\gamma = \frac{\lg(R10/R100)}{\lg(100/10)} = \lg(R10/R100)$$

R10、R100分别为10Lux、100Lux照度下的电阻值。 γ 的公差为 ± 0.1 。

- 4、最大功率损耗，
环境温度为25°C时的最大功率。
- 5、最大外加电压，
在黑暗中可连续施加给元件的最大电压。

- 1、Light resistance:
Measured at 10 Lux with standard light A (2854K color temperature) and 2hr illumination at 400-600 lux prior testing.
- 2、Dark Resistance:
Measured 10 seconds after closed 10 lux.
- 3、Gamma Characteristic:
The relation between the rate of change of resistance and the variation of incident ray may be calculated through the formula noted below:

$$\gamma = \frac{\lg(R10/R100)}{\lg(100/10)} = \lg(R10/R100)$$

R10、R100 Cell resistance at 10 lux and 100 lux , The error of γ is ± 0.1 .

- 4、Pmax:
Max.Power dissipation at ambient temperature of 25°C.
- 5、Vmax:
Max.Voltage in darkness that may be applied to the cell continuously.

规格: Specification

型号 model	最大电压 Vmax (VDC)	最大功耗 Pmax (mW)	环境温度 Ambient Temp (°C)	光谱峰值 Spectral Peak (nm)	亮电阻 Photo Resistance (K Ω)		暗电阻 Dark Resistance (M Ω)	γ 100 10	响应时间 Response Time (ms)		照度电 阻特性 Illuminance Vs Photo Resistance
					R10	R100			上升 Rise Time	下降 Decay Time	
GL5516	150	100	-30~+70	540	5~10	≤ 2	0.2	0.6	30	30	2
GL5528	150	100	-30~+70	540	10~20	2~4	1.0	0.7	20	30	3
GL5537	150	100	-30~+70	540	20~50	4~10	2.0	0.7	20	30	4
GL5539	150	100	-30~+70	540	50~90	10~15	5.0	0.8	20	30	5
GL5549	150	100	-30~+70	540	90~150	15~20	10.0	0.9	20	30	6
GL5559	150	100	-30~+70	540	150~300	20~60	20.0	0.9	20	30	6
GL5616D	150	100	-30~+70	560	5~10	≤ 2	1.0	0.6	30	30	2
GL5626D	150	100	-30~+70	560	10~20	2~4	2.0	0.6	20	30	3
GL5637D	150	100	-30~+70	560	20~50	4~10	5.0	0.7	20	30	4
GL5639D	150	100	-30~+70	560	50~90	10~15	10.0	0.8	20	30	5
GL5649D	150	100	-30~+70	560	90~150	15~20	20.0	0.9	20	30	6
GL5659D	150	100	-30~+70	560	150~300	20~60	20.0	0.9	20	30	6